


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Ученого совета ИФФВТ  
от « 24 » мая 2023 г., протокол № 10

Председатель \_\_\_\_\_ /В.В. Рыбин/  
(подпись)  
« 24 » мая 2023 г.



## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина	<b>Профессиональный электив «Материаловедение полупроводников и диэлектриков»</b>
Факультет	<b>Инженерно-физический факультет высоких технологий (ИФФВТ)</b>
Кафедра	<b>Кафедра Физического материаловедения (ФМ)</b>
Курс	<b>3</b>

Направление (специальность): **28.03.02 «Наноинженерия»**  
*код направления (специальности), полное наименование*

Направленность  
(профиль/специализация) **Нанотехнологии и наноматериалы**  
*полное наименование*

Форма обучения **очная**  
*очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)*

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 01 » сентября 2023 г.

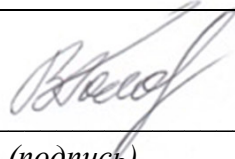
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Махмуд-Ахунов М.Ю.	ФМ	к.ф.-м.н., доцент

<b>СОГЛАСОВАНО</b>
<b>Заведующий выпускающей кафедрой Физического материаловедения</b>
 _____/В.Н. Голованов/ (подпись) (ФИО)
« 19 » мая 2023 г.



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

**Целью курса «Физика полупроводников»** является изучение природы полупроводников, физических процессов, которые в них протекают при различных внешних воздействиях, современных методов их описания. Кроме того, курс «Физика полупроводников» позволяет сформировать у студентов представления о принципах работы полупроводниковых приборов, способах их изготовления и применении.

#### **Задачи дисциплины:**

- изучение основных представлений физики полупроводников;
- ознакомление студентов с физическими основами работы современных полупроводниковых устройств;
- развитие способностей и интереса к исследованию полупроводниковых материалов и приборов на их основе, к самостоятельному мышлению и творческой деятельности.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «**Профессиональный электив «Материаловедение полупроводников и диэлектриков»**» входит в базовую часть дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавров по направлению 28.03.02 «Наноинженерия», преподается в 5-м семестре 3-го курса бакалаврам очной формы обучения.

Данная дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими частями ОПОП, а именно с курсами


- ПЭ **Материаловедение в микроэлектронике**
- ПЭ **Физические основы технологии полупроводниковых приборов**
- **Научно-исследовательская работа**
- **Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена**

После изучения данной дисциплины студент должен понимать природу физических процессов, происходящих в полупроводниках, уметь выводить основные законы, описывающие свойства полупроводников, и применять свои знания на практике.

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие входные знания, умения, навыки и компетенции, полученные в рамках изучения предшествующих дисциплин: базовые знания, умения, навыки в области общей и теоретической физики и радиофизики;

### 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-6 Проектирование приборов и устройств микроэлектроники и управление их параметрами на основе физико-	<b>Знать:</b> основные понятия, связанные с физикой полупроводников, процессами переноса носителей заряда в полупроводниковых системах, с основными явлениями на контактах полупроводника с металлами, полупроводниками, диэлектриками, применением этих явлений в приборных устройствах с применением этих явлений в приборных устройствах.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


химических свойства применяемых материалов	<p><b>Уметь:</b> применять полученные знания для анализа работы приборных объектов, использовать физические законы для предсказания поведения физических параметров полупроводниковых объемных и контактных приборов, оперировать физическими и технологическими терминами и величинами, анализировать задачи по переносу носителей заряда в полупроводниковых системах различной природы.</p> <p><b>Владеть:</b> информацией об областях применения полупроводников в приборных системах</p>
--	---

#### 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего)   2  

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 72

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		1-4	5	6-8
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	36/36		36/36	
Аудиторные занятия:				
• Лекции (в т.ч. 0 ПрП)*	18/18		18/18	
• семинары и практические занятия (в т.ч. 0 ПрП)*				
• лабораторные работы, практикумы (в т.ч. 0 ПрП)*	18/18		18/18	
Самостоятельная работа	36/36		36/36	
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Тестирования Контрольная работа Выполнение расчетных работ		Тестирования Контрольная работа Выполнение расчетных работ	
Курсовая работа	-		-	
Виды промежуточной	зачет		зачет	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


аттестации (экзамен, зачет)				
Всего часов по дисциплине	72/72		72/72	

*В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения*

*\*часы ПрП по дисциплине указываются в соответствии с УП, в случае, если дисциплиной предусмотрено выполнение отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.*

#### 4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Введение.	7	1				6	Устный опрос, тестирование
2. Статистика носителей заряда в полупроводниках	14	2		2		10	Устный опрос, тестирование Защита лабораторных работ
3. Кинетические явления в полупроводниках.	17	3		4		10	Устный опрос, тестирование Защита лабораторных работ
4. Контактные явления в полупроводниках. Электрические переходы.	18	3		3		12	Устный опрос, тестирование Защита лабораторных работ
5. Поверхностные явления в полупроводниках	18	3		3		12	Устный опрос, тестирование Защита лабораторных работ
6. Термоэлектрические и	13	3		-		10	Устный опрос,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

терромагнитные явления, эффект Холла, гальваномагнитные явления.							тестирование Защита лабораторных работ
7. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фотопроводимость. Фотовольтаические эффекты. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры.	21	3		6		12	Устный опрос, тестирование Защита лабораторных работ
Итого:	108	18		18		72	

### 5. Содержание дисциплины (модуля)

Физика полупроводников – область фундаментальной и прикладной науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования физических свойств полупроводниковых материалов и композитных структур на их основе (включая гетероструктуры, МОП структуры и барьеры Шоттки), а также, происходящих в них физических явлений, разработку и исследование технологических процессов получения полупроводниковых материалов и композитных структур на их основе, создание оригинальных полупроводниковых приборов и интегральных устройств.

Дисциплина «Физика полупроводников» рассматривает физические процессы, происходящие в объеме полупроводника, на его поверхности и на границе полупроводника с другими материалами.

#### 5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).

##### Тема 1. Введение.


Роль полупроводников в современной физике и технике. Вещества, относящиеся к полупроводникам. Особенности их кристаллической структуры и характер химической связи. Зонная структура полупроводниковых материалов. Основные особенности электрических свойств полупроводников. Влияние примесей. Основы практического использования полупроводников.

##### Тема 2. Статистика носителей заряда в полупроводниках.

Плотность квантовых состояний. Функция распределения Ферми-Дирака. Невырожденные, вырожденные и примесные полупроводники. Степень заполнения примесных уровней. Концентрация электронов и дырок. Положение уровня Ферми и концентрация носителей заряда в собственном и примесном полупроводниках. Закон действующих масс. Уравнение электронейтральности. Температурная зависимость положения уровня Ферми и концентрации носителей заряда в полупроводнике, легированном одним типом примеси, в компенсированном полупроводнике.

##### Тема 3. Кинетические явления в полупроводниках.

Электропроводность полупроводников в слабых электрических полях. Подвижность электронов и дырок. Электропроводность собственного и примесного полупроводников. Температурная зависимость подвижности и электропроводности при различных механизмах рассеяния носителей заряда. Уравнение непрерывности. Диффузионный и дрейфовый токи в полупроводнике. Соотношения Эйнштейна. Закон

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

полного тока. Неравновесные носители заряда. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Электропроводность полупроводников в сильных электрических полях.

#### **Тема 4. Контактные явления в полупроводниках. Электрические переходы.**

**4.1 Электронно-дырочный переход.** Распределение примесей, объемного заряда, свободных носителей, напряженности поля и потенциала на  $p-n$  – переходе. Энергетические диаграммы  $p-n$  – перехода в равновесном состоянии и под влиянием внешнего поля. Выпрямление на  $p-n$ -переходе. Вольт-амперная характеристика  $p-n$ -перехода. Пробой  $p-n$ -перехода. Дифференциальное сопротивление и емкость  $p-n$ -перехода.

**4.2 Контакт «металл-полупроводник». Переход Шоттки.** Полупроводник во внешнем электрическом поле. Работа выхода. Контактная разность потенциалов. Выпрямление на контакте металл-полупроводник.

**4.3 Контакт между полупроводниками одного типа проводимости.**

**4.4. Гетеропереходы.**

**4.5. Свойства омических переходов.**

#### **Тема 5. Поверхностные явления в полупроводниках.**

Уравнение Пуассона. Поверхностный потенциал. Поверхностная проводимость. Эффект поля. МДП-структура. Емкость МДП-структуры.

#### **Тема 6. Термоэлектрические и термомагнитные явления, эффект Холла, гальваномангнитные явления.**

Эффект Холла, эффект Холла в полупроводниках с двумя типами носителей заряда. Магниторезистивный эффект. Эффект Пельтье, эффект Томсона и эффект Зеебека.

#### **Тема 7. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фотопроводимость. Фотовольтаические эффекты. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры.**


Спектр отражения и спектр поглощения оптического излучения. Собственное поглощение света, прямые и непрямые переходы. Влияние внешних воздействий на собственное поглощение полупроводников. Экситонное поглощение, поглощение свободными носителями заряда, примесное и решеточное поглощение. Фоторезистивный эффект, квантовый выход, коэффициент усиления. Зависимость фототока от интенсивности света, кинетика фототока.

### **6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

Лабораторная работа №1 Определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

Цель работы: изучить статистику электронов и дырок собственного полупроводника, знакомство с зонной теорией полупроводника.

Результатом выполнения работы являются навыки анализа температурной зависимости сопротивления собственного полупроводника, соотнесения экспериментальных результатов с зонной теорией и статистикой электронов и дырок в полупроводнике.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Лабораторная работа №2. “Определение диффузионной длины и времени жизни неосновных носителей заряда в полупроводниках”

Цель работы: определение диффузионной длины и времени жизни неосновных носителей заряда. Метод основан на измерении пространственного распределения концентрации неравновесных носителей заряда, возбужденных светом.

Результатом выполнения работы являются знакомство с понятием неравновесные носители заряда, формирования понимания влияния параметров процессов генерации и рекомбинации в полупроводнике на быстроедействие полупроводниковых структур, формирование навыков измерения параметров кинетических процессов.

Лабораторная работа №3 Определение контактной разности р-п- перехода

Цель работы: из вольт-фарадной характеристики резкого р-п-перехода определить контактную разность р-п-перехода, концентрацию легирующей примеси.

Результатом выполнения работы является знакомство с теорией барьерной емкости в р-п0 переходе, формирование навыка анализа экспериментальной зависимости емкости полупроводниковой структуры от напряжения.

Лабораторная работа №4 Исследование электрических характеристик контакта металл-полупроводник

Цель работы: Изучение принципа работы диодов Шоттки, измерение и анализ вольт-амперных характеристик (ВАХ) и вольт-фарадных характеристик (ВФХ), определение основных параметров диодов.

Результатом выполнения работы является знакомство с принципом работы структур на основе барьера Шоттки, формирования навыков экспериментального анализа электрических характеристик подобных структур.

Лабораторная работа №5 Исследование статических вольт-амперных характеристик МДП-транзистора с индуцированным каналом.

**Цель работы** – ознакомиться с ВАХ и основными дифференциальными статическими параметрами полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП-транзисторов).


Результатами выполнения работы является формирование навыка измерения порогового напряжения МОПТ, его передаточных и выходных вольт-амперных характеристик, определения статических дифференциальных параметров.

Лабораторная работа №6. Исследование спектров поглощения света в полупроводниках

Цель работы – Определение спектральной зависимости коэффициента поглощения света в полупроводниках. Выявление области собственного поглощения. Определение ширины запрещенной зоны образца

Результатом выполнения работы является формирование навыков работы с спектрометром СФ-46, представлений о зонной структуре прямозонного и



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

непрямого полупроводника, экспериментального анализа спектров поглощения полупроводника.

Лабораторная работа №7. Исследование фотопроводимости в полупроводниках

Цель работы – изучение фотоэлектрических в полупроводниках. Измерение спектральной зависимости полупроводникового фотоприемника, определение красной границы фотоэффекта. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда.

Результатом выполнения работы является формирование представления о фотопроводимости в полупроводнике, механизмов образования неравновесных носителей заряда, навыков экспериментального определения времени жизни неравновесных носителей заряда методом фотопроводимости.

## 7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ


*Данный вид работы не предусмотрен УП.*

## 8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ


*Данный вид работы не предусмотрен УП.*

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Строение полупроводников. Кристаллическая решетка. Классификация кристаллических решеток по характеру химической связи.
2. Кристаллическая решетка полупроводников. Симметрия кристаллов. Решетки Бравэ. Классификация кристаллических решеток по отношению к операциям симметрии.
3. Кристаллическая решетка полупроводников. Решетки Бравэ. Положение узлов кристаллической решетки. Положение и ориентация плоскостей и направлений в кристалле. Индексы Миллера.
4. Кристаллическая решетка полупроводников. Дефекты кристаллической решетки. Классификация дефектов.
5. Обобщение электронов в кристалле. Образование энергетических зон. Деление твердых тел на проводники, полупроводники и диэлектрики.
6. Обобщение электронов в кристалле. Образование энергетических зон. Влияние дефектов на зонную структуру твердых тел.
7. Квантовомеханическое описание электронов в кристаллах. Приближение сильной и слабой связи. Волновые функции и энергетический спектр почти свободных электронов.
8. Волновые функции и энергия электронов, движущихся в периодическом поле кристалла. Эффективная масса электронов.
9. Функция распределения электронов в металле. Уровень Ферми и энергия Ферми. Связь энергии Ферми с концентрацией электронного газа в металле.
10. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей в собственных полупроводниках. Зависимость концентрации свободных носителей от температуры.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. Положение уровня Ферми и концентрация носителей в примесных полупроводниках n-типа. Область низких температур, область истощения примеси, область собственной проводимости.
12. Положение уровня Ферми и концентрация носителей в примесных полупроводниках p-типа. Область низких температур, область истощения примеси, область собственной проводимости.
13. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей в собственных и примесных полупроводниках. Закон действующих масс.
14. Нормальные колебания решетки. Спектр нормальных колебаний. Температура Дебая.
15. Фононы. Зависимость концентрации фононного газа от температуры.
16. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Закон Дебая. Закон Дюлонга и Пти.
17. Теплоемкость твердых тел. Электронная теплоемкость.
18. Теплопроводность твердых тел. Решеточная и электронная теплопроводность.
19. Дрейф электронов под действием внешнего поля. Подвижность носителей заряда. Связь подвижности с временем релаксации и длиной свободного пробега.
20. Удельная электропроводность проводников. Связь электропроводности с подвижностью носителей заряда. Электропроводность невырожденного и вырожденного газов.
21. Удельная электропроводность проводников. Электропроводность невырожденного и вырожденного газов. Закон Видемана-Франца-Лоренца.
22. Удельная электропроводность проводников. Связь электропроводности с подвижностью носителей заряда. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры.
23. Электропроводность чистых металлов и сплавов. Закон Нордгейма. Правило Матиссена об аддитивности удельного сопротивления.
24. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Закон действующих масс. Зависимость примесной проводимости от температуры.
25. Эффекты сильного поля (разогрев электронного газа; эффект дрейфового насыщения; термоэлектронная ионизация; ударная ионизация; электростатическая ионизация).
26. Эффект Ганна. Отрицательная дифференциальная проводимость. Физические принципы работы диодов Ганна.
27. Взаимодействие света с веществом. Коэффициенты отражения и поглощения. Закон Бугера-Ламберта.
28. Взаимодействие света с веществом. Собственное поглощение света в полупроводниках, поглощение свободными носителями заряда и поглощение примесными центрами.
29. Взаимодействие света с веществом. Фотопроводимость полупроводников и ее использование в электронике.
30. Фотовольтаические эффекты. Эффект Дембера.
31. Вентильный эффект. Фото- ЭДС и её практическое использование.
32. Гальваномагнитные явления. Эффект Холла. Связь постоянной Холла с концентрацией и знаком носителей заряда.


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

33. Гальваномагнитные явления. Эффекты Эттингсгаузена и Нернста. Изменение электропроводности проводников в магнитном поле.
34. Контакт двух металлов. Контактная разность потенциалов. Внешняя и внутренняя контактная разность потенциалов. Толщина двойного электрического слоя, возникающего в месте контакта двух металлов.
35. Контакт металла с полупроводником. Влияние контактного поля на энергетические уровни полупроводника. Выпрямляющие свойства контакта металла с полупроводником. Диоды Шоттки.
36. P-n-переход. Вольт-амперная характеристика p-n-перехода.
37. Гетеропереходы. Вольт-амперная характеристика гетероперехода.
38. Поверхностные явления в полупроводниках. Уровни Тамма
39. Перенос зарядов через тонкие полупроводниковые пленки.


## 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
1. Введение.	Проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена	6	Устный опрос
2. Статистика носителей заряда в полупроводниках	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	10	Устный опрос, Проверка решения задач, оценка доклада
3. Кинетические явления в полупроводниках.	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	10	Устный опрос, Проверка решения задач, оценка доклада
4. Контактные явления в полупроводниках. Электрические переходы.	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	12	Устный опрос, Проверка решения задач, оценка доклада
5. Поверхностные явления в полупроводниках	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	12	Устный опрос, Проверка решения

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

			задач, оценка доклада
6. Термоэлектрические и термомагнитные явления, эффект Холла, гальваномагнитные явления.	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	10	Устный опрос, Проверка решения задач, оценка доклада
7. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фотопроводимость. Фотовольтаические эффекты. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры.	Проработка учебного материала, решение задач, подготовка доклада, подготовка к сдаче лабораторных работ, подготовка к сдаче экзамена	12	Устный опрос, Проверка решения задач, оценка доклада

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### а) Список рекомендуемой литературы

#### Основная:

1. Филяк, М. М. Основные физические процессы в проводниках, полупроводниках и диэлектриках : учебное пособие / М. М. Филяк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 с. — ISBN 978-5-7410-1188-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/54132.html>

2. Кралин, А. А. Электротехническое и конструкционное материаловедение : учебное пособие / А. А. Кралин, С. Н. Охулков, Е. А. Ершова. — Нижний Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-502-01193-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151385>

#### Дополнительная:

1. Дроздов, В. Г. Электроматериаловедение : учебное пособие / В. Г. Дроздов. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. — 70 с. — ISBN 978-5-8285-1092-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160078>» (Дроздов, В. Г. Электроматериаловедение : учебное пособие / В. Г. Дроздов. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. — ISBN 978-5-8285-1092-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160078>


2. Романовский, М. Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. Часть 1. Основные структуры полупроводниковых интегральных схем : учебное пособие / М. Н. Романовский. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 123 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/13933.html>


3. Угольников, А. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение : учебник / А. В. Угольников. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-4497-0022-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/82235.html>

#### Учебно-методическая:

1. Махмуд-Ахунов М. Ю. Методические указания для самостоятельной работы студентов по профессиональному элективу «Материаловедение полупроводников и диэлектриков» для студентов бакалавриата всех форм обучения направлений подготовки: 28.03.02 «Наноинженерия», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» / Ульян. гос. ун-т, ИФФВТ. - 2022. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/14665>

Согласовано:

Ведущий специалист ООП \_\_\_\_\_ / Чамеева А.Ф. /  / \_\_\_\_\_ 2023  
(Должность работника научной библиотеки) (ФИО) (подпись) (дата)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## **б) Программное обеспечение**

1. ОС Microsoft Windows
2. Microsoft OfficeStd 2016 RUS
3. «МойОфис Стандартный»

## **в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы**

### **1. Электронно-библиотечные системы:**

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2023]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2023]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.


1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Букап». – Томск, [2023]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2023]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС **Znanium.com** :электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2023]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

**2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон.дан. - Москва :КонсультантПлюс, [2023].

### **3. Базы данных периодических изданий:**

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2023]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». – Москва, [2023]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

**4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»:** электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2023]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

**5. Российское образование:** федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.


**6. Электронная библиотечная система УлГУ :** модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:

Инженер ведущий / Щуренко Ю.В. /  / \_\_\_\_\_  
Должность сотрудника УИИТ ФИО подпись дата

## 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитории для проведения лекций, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса, размещёнными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации». Для проведения лабораторных работ используется следующее оборудование.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

### 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

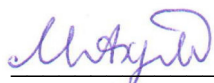
– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик



подпись

доцент, Махмуд-Ахунов Марат Юсупович

должность, ФИО